



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

## 一种低温制备大块致密高纯单相Y2SiO5陶瓷快体材料的方法

文献类型: 专利

**作者** 周延春, 孙子其, 李美栓

**发表日期** 2009-07-29

**专利国别** 中国

**权利人** 中国科学院金属研究所

**公开日期** 2013-06-19

**语种** 中文

**专利申请号** 200610047768.X

**源URL** [<http://210.72.142.130/handle/321006/68238>]

**专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所

**推荐引用方式** 周延春, 孙子其, 李美栓. 一种低温制备大块致密高纯单相Y2SiO5陶瓷快体材料的方法. 2009-07-29.  
**GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

88

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。